# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-278535

(43)Date of publication of application: 28.10.1997

(51)Int.Cl.

CO4B 35/628 CO4B 35/49 HO1L 41/187 HO1L 41/22

(21)Application number: 08-089217

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

11.04.1996

(72)Inventor: HORIUCHI KAZUSHI

# (54) PRODUCTION OF CERAMIC

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a ceramic excellent in piezoelectricity and mechanical strength etc., even if subjected to low-temperature baking, by calcinating stock powder with the particle size below a specified level at a temperature comparable to the baking temperature or higher followed by grinding and then baking.

SOLUTION: First, stock powder such as of PbO, SrCO3, ZnO, SnO2, Nb2O5, TiO2, ZrO2 and/or MnCO3 is ground so as to be  $\leq 0.5 L\mu m$  in particle size using e.g. a ball mill. Secondly, the ground powder is calcined at a temperature comparable to the baking temperature or higher and then ground so as to be  $\leq 0.5 \mu m$  is particle size. Thirdly, a binder is added to the resultant powder followed by homogeneous mixing, and the resultant mixture is molded to a desired shape. Finally, the molding is heat–treated to burn off the binder and then baked to obtain the objective ceramic. By this method, because the particle size is small and the temperature of the calcination is comparable to or higher than the baking temperature, the rate of reaction is raised and the crystallinity of the stock is improved, thus obtaining the objective ceramic having electrical properties comparable to those of ceramics produced by high–temperature baking and excellent in mechanical strength.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

11.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of

24.01.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-278535

(43)公開日 平成9年(1997)10月28日

(51) Int.CL <sup>6</sup>	载别包号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所	
CO4B 35/6	528		C04B 3	-		В	
35/4				5/49		Q	
H01L 41/			HOIL 4		101		
41/2	22		4	11/22		2	
			农陆查留	來簡求	菌求項の数3	OL (全3頁)	
(21)出顧番号	特顯平8-89217		(71)出廢人	0000058	21		
					品産業株式会社		
(22)出廢日	平成8年(1996)4月11日		(2.5)		<b>有其心大字門真</b>	1006番池	
			(72) 死明者		_	AAAARIG INTERNA	
				大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 <u>企業株式会社内</u>			
			(74)代建人	弁理士	闷本 智之	(外1名)	
			1				

#### (54)【発明の名称】 セラミックスの製造方法

# (57)【要約】

【課題】 低温で焼成したとしてもすぐれた電気特性を 有するセラミックスを提供することを目的とするもので ある。

【解決手段】 粒子径をり、5 μ m以下の原料紛体を焼成温度と同等以上の高温で仮焼し、次に粉砕して成形した後庭成するものであり、粒子径を小さくして高温で仮焼することにより、原料紛体の反応を促進し結晶性を向上させることができるので、電気特性にすぐれたセラミックスを得ることができる。

1

#### 【特許請求の範囲】

【語求項1】 粒子径がり、5 μ m以下の原料紛体を焼成温度と同等以上の温度で仮焼し、紛砕した後に、焼成することを特徴とするセラミックスの製造方法。

【語求項2】 原料粉体は、鉛系の材料であることを特徴とする請求項1に記載のセラミックスの製造方法。

【請求項3】 仮境後の紛砕した粉体の粒子径が0.5 μ m以下であることを特徴とする請求項1 に記載のセラミックスの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001] .

【発明の属する技術分野】本発明は例えば圧電磁器など のセラミックスの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、原料粉体の仮焼は焼成温度よりも低い温度で行われていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】原料紛体の粒径が1. ① μ m以下と小さくなるにしたがい。 線成温度を低くすることができる。 しかし、圧電材料においては、原料粉体の粒径を小さくして低温線成すると、圧電性が低く、高強度、高出力のセラミックスを得ることが困難であった。

【①①①4】そとで、本発明は低温焼成においても優れた圧電性を示し、さらに高強度、高出力を可能にするセラミックスを提供することを目的とするものである。 【①①05】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明は、粒子径が0.5μm以下の原料粉体を焼成温度と同等以上の温度で仮旋し、粉砕した後に、焼成するものであり。原料粉体の粒子径を微細にし、仮焼温度を焼成温度と同等以上にすることにより、反応速度が増し、結晶性が向上するので、低温焼成においても高温焼成と同様の圧電性を示し、さらに結晶粒径の微細化にと

もない高強度のセラミックスを得ることができる。 【0006】

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、粒子径が0.5μm以下の原料紛体を焼成温度と同等以上の温度で仮焼し、紛砕した後に焼成するものであり、原料粉体の粒子径を散細にし、仮焼温度を焼成温度と同等以上にすることにより、反応速度が増し、結晶性が向上するので、低温焼成においても高温焼成と同様の圧電性を示し、さらに結晶粒径の微細化にともない高強10度磁器を得ることができる。

【0007】 語求項2 に記載の発明は、原料粉体として 鉛系の材料を用いるものであり、原料粉体の粒子径を微 細にすることにより、焼成温度と同等以上の温度で仮焼 したとしても、 記成分の飛翔置が少なく、結晶性のすぐ れた粉体を得ることができるので、低温焼成した場合で も、圧電性のよい高出力、高強度のセラミックスを得る ことができる。

[0008] 詰求項3に記載の発明は、仮焼後の紛砕した紛体の粒子径を0.5μm以下とするものであり、原料紛体の粒径と同等以下にすることにより、より低温で焼成することができる。

【① 0 0 9 】以下本発明の一実施の形態について説明する。

(実施の形態1)まず、出発原料として、PDO、SECO<sub>1</sub>、ZnO、SnO<sub>2</sub>、ND<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、T<sub>1</sub>O<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>, MnCO<sub>2</sub>を用いて、PD(Zn<sub>1/2</sub>ND<sub>2/2</sub>)<sub>e.es</sub>(Sn<sub>1/2</sub>ND<sub>2/2</sub>)<sub>e.ss</sub>Ti<sub>e.ss</sub>Zr<sub>e.ss</sub>O<sub>2</sub>+0.5 wt%MnO<sub>2</sub>となるように秤量した。次にこれらの原料に水、分散剤などを加えて、媒体撹拌ミルまたはボールミル等で湿式混合し、混合粒子径が(表1)に示すようになるようにした。

[0010]

【表1】

SEST AVAILABLE COFT

	万子	仮焼	经路	<b>焼</b> 坟	設装	麗霉素	
No.	经仓	64 St	P) 12	温度	密度		ko [
10	g m_	Ť.	# B	SC.	kg/n3	180	
1*	0.6	950	0.3	1100	7600	1020	0.5
2*	0.8	950	0.3	1150	7637	1089	0.53
3*	0.6	950	0.3	1290	2700	1130	0.55
4*	0,6	1170	i	1150	7527	953	0.47
5*	0.6	1110	0.4	1150	7714	1080	0.533
8*	0.5	950	0.45	1100	7620	1045	0.51
7*	0.5	950	0.45	1150	7730	1078	0.528
2*	0.5	95D	0.45	1200	7860	1143	0.55
g#	0.5	1170	1	5150	7597	870	0.488
10.		1170	0.85	1150	7780	1170	0.55
l ji	0.5	1170	0.45	1150	7880	1300	0.579
líż	0.5	1170	0.2	1100	7890	1285	0.581
13	0.5	1170	0.2	1150	7950	1357	0.58
14	0.5	1176	0.2	1200	7950	1360	0.5ช
1 15	0.5	1200	0.2	1100	7896	1299	0.583
i ë	0.5	1200	0.2	1150	7947	1330	0.588
17	0.5	1200	0.2	1200	7980	1378	0.592
18	0.5	1200	0.1	1150	7980	1380	0.587
192		1000	0.5	1100	7700	1200	0 531
20:		1000	0.5	1150	7880	1223	0.55
211		1000	0.5	1 200	1950	1220	0.548
	0.2	1150	0.8	1100	7588	800	0.461
23:		1150	0.8	1150	7630	1037	0.504
24:		1150	Ų. 8	1200	7676	1099	0.51)
25	0.2	1150	0.4	1100	7803	1278	0.578
26	0.2	1150	0.4	1150	7960	1329	0.584
27	0.2	1200	0.4	1150	7977	1497	0.538
28	0.12	1150	0.2	1100	7589	1338	9.58
29	0.12	1150	0.2	1150	7981	1390	0.587
30	0.12	1200	0.2	1150	7985	1420	0.59

【0011】次いで、この混合粉でスラリーを作成し、 乾燥後、粉体のままでマグネシア磁器坩堝に入れ、(表 1) の温度条件で2時間仮焼した。解砕後、混合時と同 じ条件でボールミルまたは媒体資控ミル等で湿式粉砕し た。乾燥後、バインダーを加え、錯潰機で均質に撹拌し た後、32メッシュの篩を用いて整位を行った。この粉 体を直径13mm、厚み1mmの円板に70MPaの圧 力で成形した。次いでこの成形物を700°Cの空気中で 熱処理を行ってバインダーを焼却した。バインダーの焼 却後鉛成分の飛散を防ぐために、1100~1200 ℃、空気中で競成を行った。次にこの競結体を厚みを 0. 3mmに平面研磨後、電極は真空蒸着でCr-Au をつけた。分極は150℃のシリコン油中で3kV/m mの直流電流を30分印刷して行った。また圧電定数を 共振 - 反共振法で測定した。その結果を(表1)に記 す。(表1)から明らかなように、従来の工法では、焼 成温度が1290℃以上でなければ得られない圧電特性 が、本実施の形態による圧電セラミックスは、混合粒径 を(). 5 mm以下に粉砕し、仮焼温度を焼成条件と同等 以上で行った紛体をO.5µm以下に紛砕した場合、1 100℃の低温焼箱の場合でも誘電率が1270以上箱

3

台係敷が()。58以上と従来の製造方法以上の圧電性が 得られることがわかる。

【0.012】さらに好ましくは複合粒径を $0.2\mu$ m以下、また仮焼後の粉体の粒径を $0.2\mu$ m以下にすることによりさらにすぐれた圧電特性を有する圧電磁器を得ることができる。

[0013]なお、本実経の形態での組成は一例であって、他にもPbO-TiOz-ZrOz-(2n,ハb,ハ)Oz, PbO-TiOz-ZrOz-(Mg,ハNb,ハ)Oz, PbO-TiOz-(Ni,ハNb,ハ)Oz, PbO-TiOz-(Sn,ハNb,ハ)Oz, PbO-TiOz-(Sn,ハNb,ハ)Oz, など鉛を含む材料つまり固相反応を発生するセラミック材料についても同様の作用を得た。

#### [0014]

【発明の効果】以上のように、本発明によると、例えば セラミックスの組成がPb〇-2g〇z-Ti〇ュ系のよ うな鉛系を含む圧電材料の場合、仮旋段階で結晶性の優 れた紛体を得ることができるもので、その粉体を用いて 得られた焼結体は、低温旋結した場合でも高温液成の場 合と同様以上の圧電性の良い高出力・高強度を有するも のである。